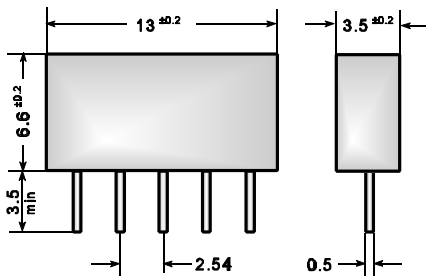
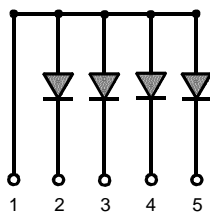


Small Signal Diode Arrays
Dioden Sätze mit Allzweckdioden


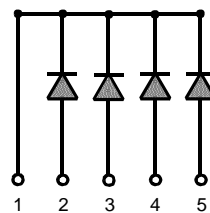
Dimensions / Maße in mm

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nominal power dissipation Nenn-Verlustleistung | 200 mW |
| Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung | 80 V |
| 5 Pin-Plastic case 5 Pin-Kunststoffgehäuse | 13 x 3.5 x 6.6 [mm] |
| Weight approx. Gewicht ca. | 0,6 g |

Standard packaging: bulk
Standard Lieferform: lose im Karton



"DAP": com. anodes / gemeinsame Anode



"DAN": com. kathodes / gemeinsame Kathode

Maximum ratings
Grenzwerte

| Type Typ | Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspg. V_R [V] | Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RM} [V] |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| DAN 401 | 80 | 80 |
| DAP 401 | 80 | 80 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Max. average forward rectified current, R-load, For one diode operation only For all diodes together | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | I_{FAV} 100 mA ¹⁾ I_{FAV} 150 mA ¹⁾ |
| Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last, Für eine einzelne Diode Für alle Dioden zusammen | $T_U = 25^\circ\text{C}$ | I_{FAV} 100 mA ¹⁾ I_{FAV} 150 mA ¹⁾ |

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Peak fwd. surge current, 50 Hz half sine-wave $T_A = 25^\circ\text{C}$ I_{FSM} 500 mA
 Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur T_j – 50...+150°C
 Storage temperature – Lagerungstemperatur T_s – 50...+150°C

Characteristics **Kennwerte**

Forward voltage $T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 10\text{ mA}$ V_F < 1 V
 Durchlaßspannung

Leakage current $T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 20\text{ V}$ I_R < 25 nA
 Sperrstrom

Reverse recovery time $I_F = 10\text{ mA}$ through/über t_{rr} < 4 ns
 Sperrverzug $I_R = 10\text{ mA}$ to/auf $I_R = 1\text{ mA}$

Thermal resistance junction to ambient air R_{thA} < 85 K/W ¹⁾
 Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden